

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成29年2月9日(2017.2.9)

【公開番号】特開2016-208046(P2016-208046A)

【公開日】平成28年12月8日(2016.12.8)

【年通号数】公開・登録公報2016-067

【出願番号】特願2016-141167(P2016-141167)

【国際特許分類】

H 01 L	21/8234	(2006.01)
H 01 L	27/088	(2006.01)
H 01 L	29/786	(2006.01)
H 01 L	21/336	(2006.01)
H 01 L	21/8242	(2006.01)
H 01 L	27/108	(2006.01)
H 01 L	27/10	(2006.01)
H 01 L	27/146	(2006.01)

【F I】

H 01 L	27/08	1 0 2 E
H 01 L	29/78	6 1 3 Z
H 01 L	29/78	6 1 8 B
H 01 L	29/78	6 2 7 F
H 01 L	27/10	3 2 1
H 01 L	27/10	4 6 1
H 01 L	27/14	C

【手続補正書】

【提出日】平成28年12月14日(2016.12.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

レジスタアレイと、

前記レジスタアレイと機能的に接続されているALUと、

前記ALUと機能的に接続されている命令レジスタと、を有し、

前記レジスタアレイ、前記ALU及び前記命令レジスタの少なくとも一は、第1のトランジスタと、前記第1のトランジスタ上方の第2のトランジスタと、を有し、

前記第1のトランジスタのチャネル形成領域は、シリコンを有し、

前記第2のトランジスタは、チャネル形成領域を酸化物半導体層に有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第2のトランジスタのソース電極又はドレイン電極の一方と電気的に接続されていることを特徴とする処理装置。

【請求項2】

レジスタアレイと、

前記レジスタアレイと機能的に接続されているALUと、

前記ALUと機能的に接続されている命令レジスタと、を有する処理装置であって、

前記処理装置の一部は、第1のトランジスタと、第2のトランジスタと、を有し、

前記第2のトランジスタは、チャネル形成領域を酸化物半導体層に有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第2のトランジスタのソース電極又はドレイン電極の一方と電気的に接続されていることを特徴とする処理装置。

【請求項3】

請求項1又は請求項2に記載の処理装置の作製方法であって、

第1の熱処理を経て前記酸化物半導体層を形成し、

前記第1の熱処理の処理中に、不活性ガスを含む雰囲気から酸素を含む雰囲気に切り替えることを特徴とする処理装置の作製方法。